



ДИОДНЫЙ СИМИСТОР

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема К1182КП4П является высоковольтной интегральной схемой, функционально аналогичной диодному симистору с фиксированным напряжением открывания.

Одно из возможных применений ИС - коммутация тока через нити подогрева электролюминесцентных ламп, последовательно включенных диодному симистору и РТС-термистору, до момента зажигания лампы.

ОСОБЕННОСТИ

- Максимальный ток – 100 мА
- Фиксированное напряжение открывания (от 10 В до 340 В с шагом 7.5 В по желанию потребителя)
- Малый разброс напряжения открывания (не более 10%)

ТИПОНОМИНАЛЫ

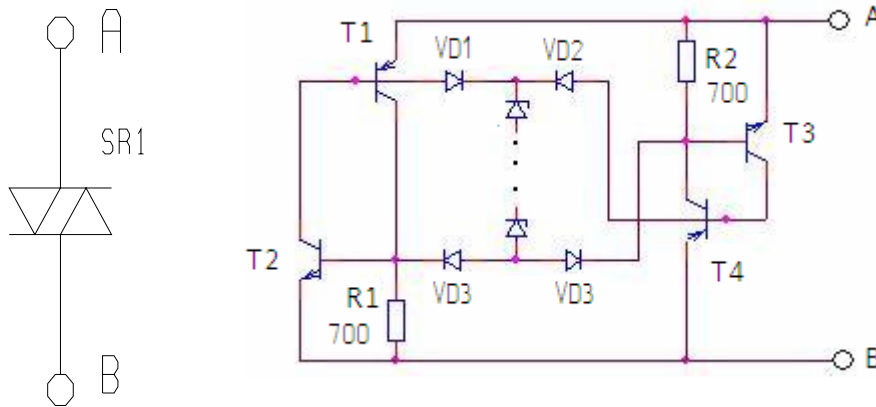
К1182КП4П - напряжение открывания 165 В



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Номер вывода	Обозначение	Назначение вывода
1	А	Первый вывод симистора
2	NC	Не использовать
3	В	Второй вывод симистора

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМЫ



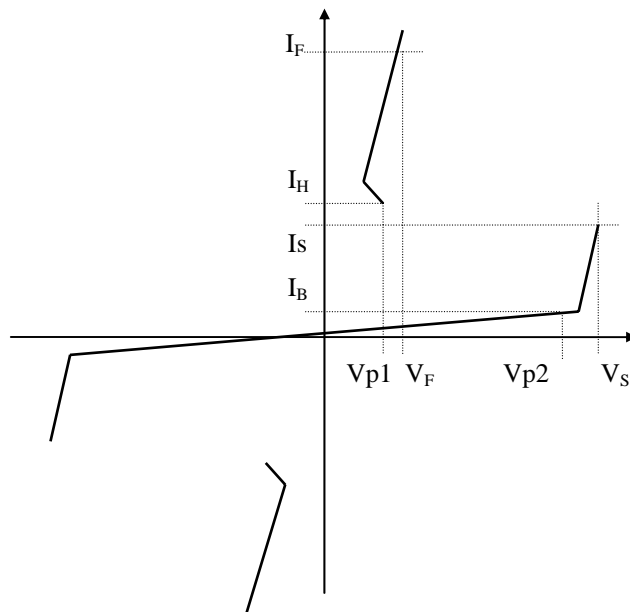
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25°C)

Наименование параметра	Букв. обозн.	Норма не менее	Тип. значен.	Норма не более
Напряжение отпирания симистора, В К1182КП4П	U _s	155	165	175
Ток переключения, мА	I _s	5.0	7.0	10.0
Ток удержания, мА К1182КП4П	I _h	5.0	-	15
Ток в закрытом состоянии, мкА К1182КП4П V _{p2} =140В	I _b	-	-	100
Падение напряжения во включенном состоянии, В (I _F =1.0 А)	U _F	-	3.5	4.0

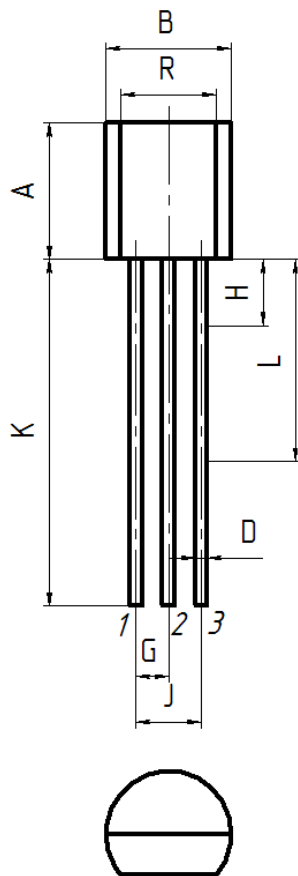
ПРЕДЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Буквенное обозн.	Норма не менее	Норма не более	Един. измер.
Температура окружающей среды	T _A	-40	85	°C
Температура хранения	T _{stg}	-55	150	°C

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-92



миллиметры		
	МИН	МАКС
A	4.32	5.33
B	4.45	5.20
C	3.18	4.19
D	0.37	0.55
G	1.15	1.39
H	-	2.54
J	2.42	2.66
K	12.70	-
L	-	-
N	2.04	2.66
R	3.43	-
S	0.39	0.50